10年 月22日拍成 **40**年

闪电击中自 由女神像

避雷针





定义法

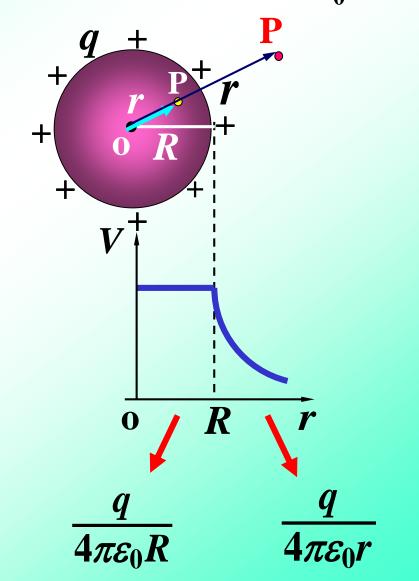
$$V_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_P}$$

电势叠加原理

$$V_P = \int_q rac{\mathrm{d}q}{4\piarepsilon_0 r}$$

上节课的相关内容

$$V_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_P}^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

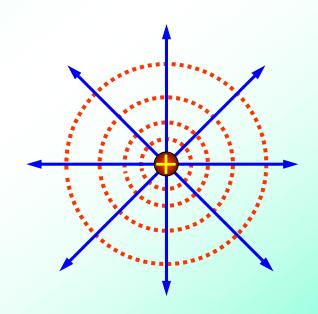


上节课的相关内容

电场强度与电势的关系

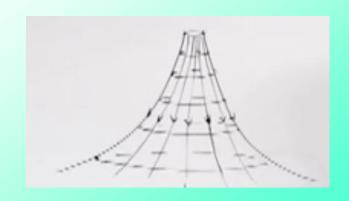
积分关系: $V_a = \int_a^{V=0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

微分关系: $\vec{E} = -grad V$

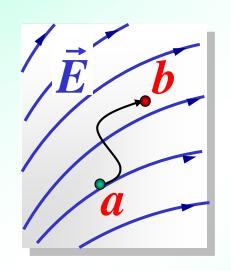


等势面与电场线的关系:

- (1) 电场线与等势面处处正交
- (2) 电场线方向指向电势降低方向
- (3) 若相邻等势面电势差相等



上节课的相关内容



电场力作功 = 静电势能的减少

$$A_{ab} = \int_a^b q \vec{E} \cdot d\vec{l} = q(V_a - V_b) = \boxed{qV_a} - \boxed{qV_b}$$

q在电场中的静电势能 W = qV

$$W = qV$$

七、静电场中的导体

- 1. 导体的静电平衡
 - (1) 静电感应

$$\vec{E} = 0$$
,导体不带电时

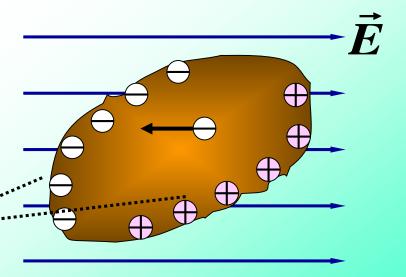
电中性

在电场中放入一导体

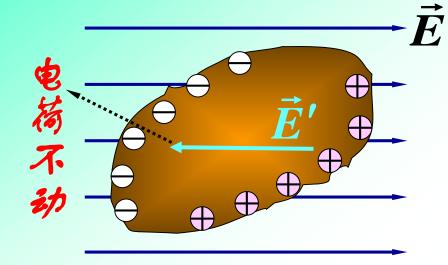
导体上电荷重新分布

——静电感应

感应电荷



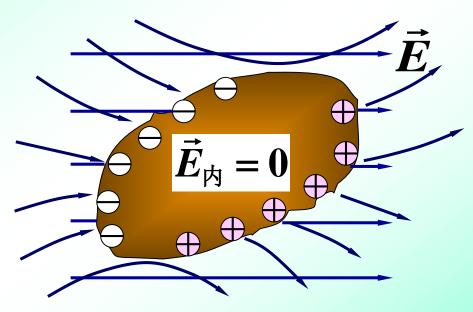
(2) 静电场与导体的相互作用



电荷积累到一定程度

$$ec{E}' = -ec{E}$$
 $ec{E}_{eta} = ec{E} + ec{E}' = \mathbf{0}$

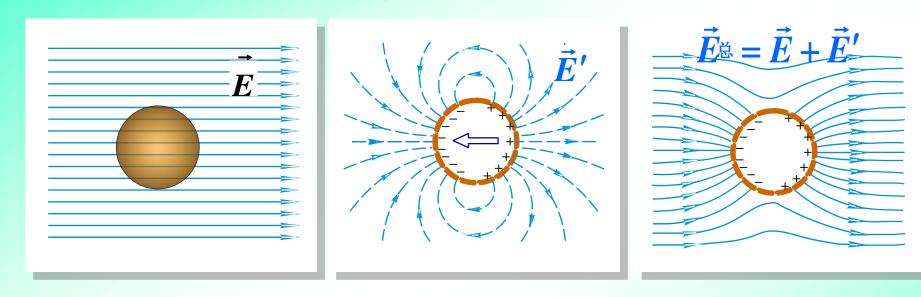
导体达静电平衡



导体外的电场

$$\vec{E}_{\%} = \vec{E}_{\%}' + \vec{E}$$

导体球在均匀电场中



导体在电场中的特点:

- 1°导体内的自由电荷,在电场力作用下 移动,从而改变原有的电荷分布。
- 2°电荷分布不同,影响电场分布。

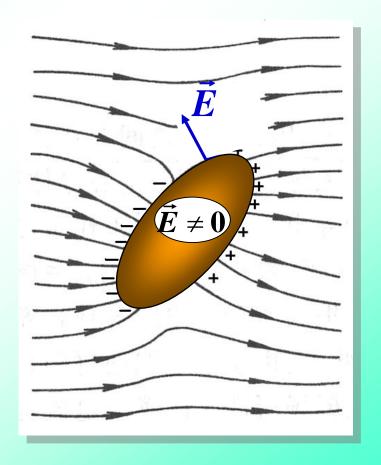
(3) 导体的静电平衡条件 静电平衡状态

——导体表面和内部都没有电荷的定向运动

静电平衡条件

- ① 导体内部任何一点处的电场强度 $\vec{E} = 0$
- ② 导体外表面处电场强度的方向垂直表面

反证法 可证明

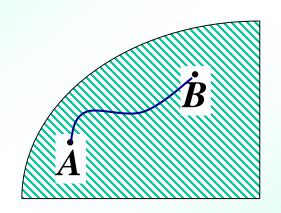


(3) 导体的静电平衡条件

推论: ① 导体是等势体

证明: :导体内处处 $\vec{E}=0$

任意两点的电势差



$$\Delta V_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$
 ∴导体内 $V =$ 常量

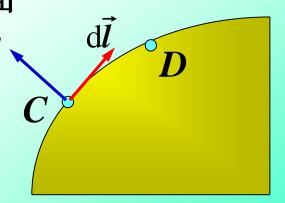
② 导体表面是等势面

证明: :: 导体表面处处 \vec{E} 上表面

任意两点的电势差

$$\Delta V_{CD} = \int_{C}^{D} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

:. 导体表面上V = 常量



2. 静电平衡时导体上的电荷分布

(1) 导体内部没有净电荷, 电荷分布在外表面上

证明: 1°体内无空腔

紧贴导体表面内作高斯面 5 如图

根据高斯定理

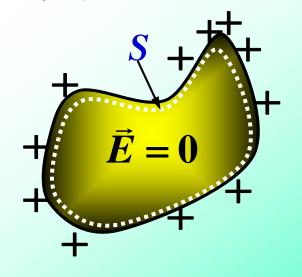
$$\oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = rac{1}{arepsilon_0} \sum_{S
eq 0} q_i$$

静电平衡时,导体内部各处

$$\vec{E} = 0$$

那么
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$
 则有 $\sum_{Sh} q_i = 0$

: 导体内部没有净电荷



2°体内有空腔,腔内无其它带电体时,电荷全分布在导体外表面上

反证法: 假设内表面的a点处有电荷q (>0)

从q发出的一条电场线L,

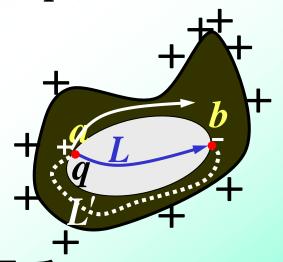
设其在内表面交于b点

则a、b两点的电势差为

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} > 0$$

$$(\text{He}L)$$

$$\nabla V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



相矛盾

因此内表面上无电荷!

电荷在外表面如何分布?

:.导体上的电荷全分布在外表面!

(2) 表面上的面电荷密度 σ 与该处的E成正比

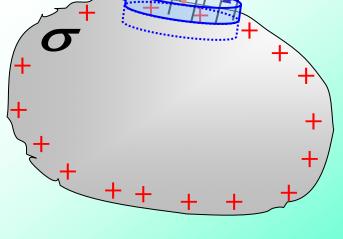
证明:如图取高斯面S,根据高斯定理

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \Delta S$$

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{S \nmid i} q_{i} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sigma \Delta S$$

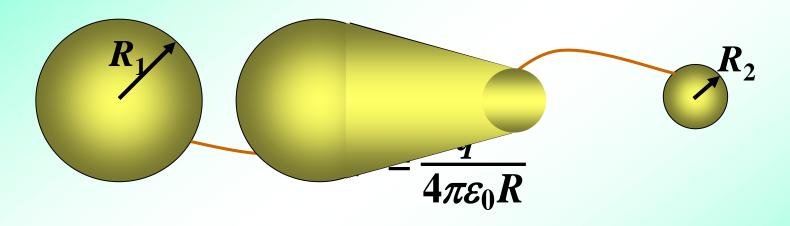
则有 $E \Delta S = \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma \Delta S$

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad || \mathbb{P} | \sigma = \varepsilon_0 E$$



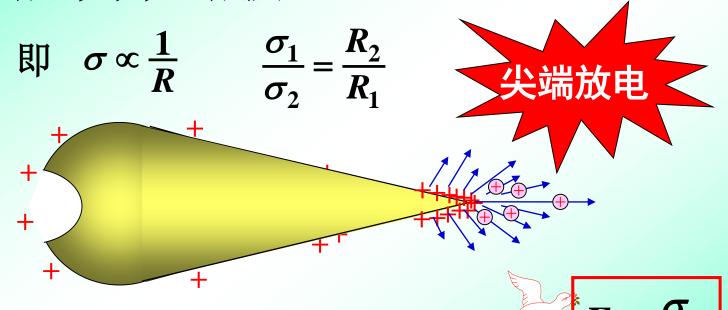
- ${}^{\circ}\vec{E}$ 是导体表面电荷及外面电荷的合场强!
- 2°上式并没有给出 σ 的分布!

(3) 孤立导体表面上各处的面电荷密度 σ 与各处表面曲率半径 R 成反比 即 $\sigma \propto \frac{1}{R}$



两球用导线相连
$$V_1 = V_2$$
 $\frac{q_1}{R_1} = \frac{q_2}{R_2}$
$$\frac{\sigma_1 \cdot 4\pi R_1^2}{R_1} = \frac{\sigma_2 \cdot 4\pi R_2^2}{R_2} \qquad \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

(3) <u>孤立导体</u>表面上各处的面电荷密度σ与各处 表面曲率半径R 成反比



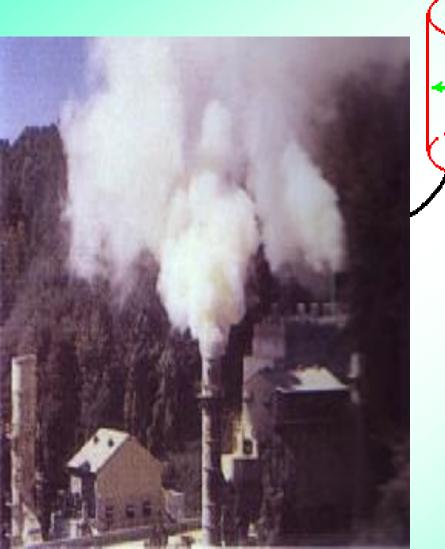
平坦处: R大 σ 小,则E 小;

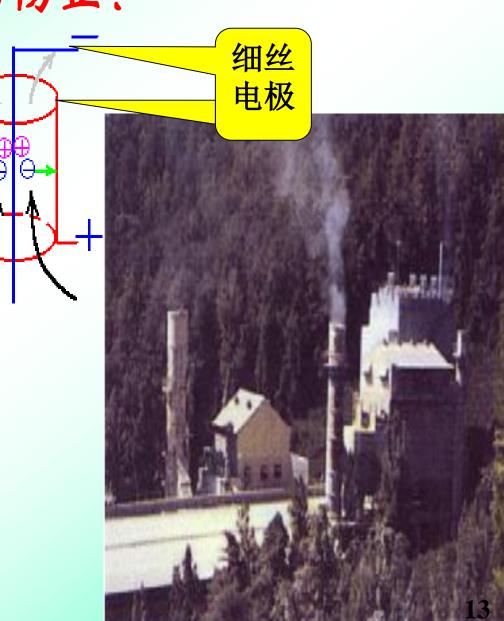
尖端处: R 很小, σ 很大, 则E 很强;

凹面处: 曲率为负值, σ 更小,则E很弱.

尖端放电的应用与防止:

静电除尘

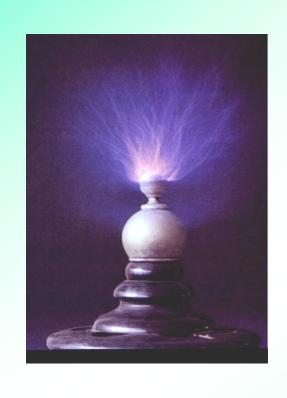




尖端放电的应用与防止:

分裂导线

(减少电晕放电损失)









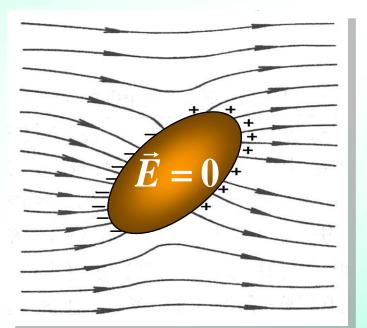




两分裂



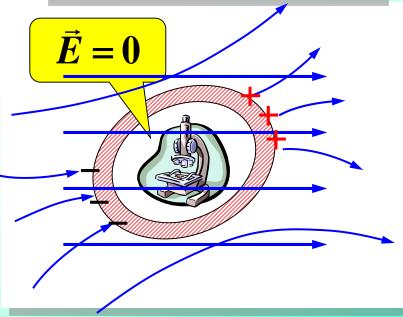
- 3. *静电屏蔽* 导体壳: (静电平衡时)
- (1) 腔内无带电体情况 内表面无电荷 腔内 $\vec{E} = 0$ (无场区)



外部电场不影响内部

——静电屏蔽







汽车是个静电屏蔽室

(2) 腔内有带电体情况 导体壳感应带电:

> 内表面电荷与腔内电荷 等值异号

> 外表面电荷与腔内电荷·等值同号

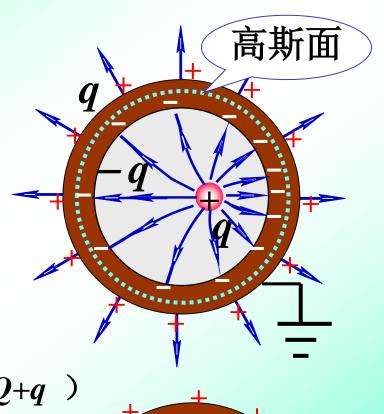
(若导体壳带电Q则外表面上电荷为 Q+q)

导体壳接地:

内部电场不影响外部

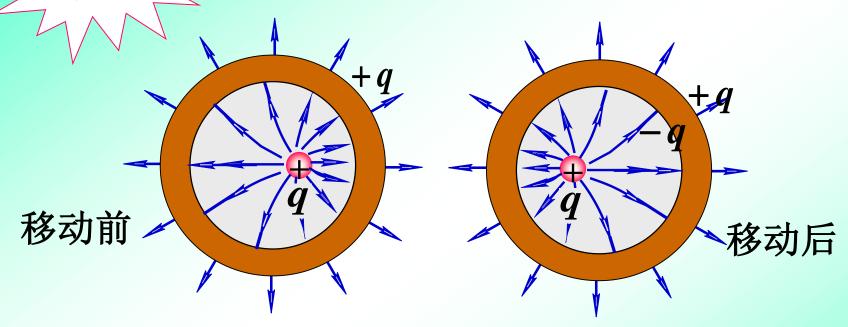
——静电屏蔽

────── 屏蔽内场

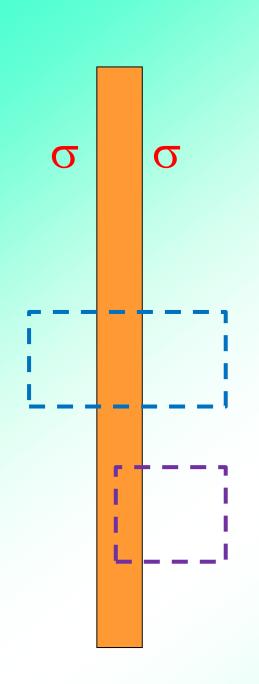


+

讨论 $\overline{}$ 腔内电荷q 移动时:



内表面带电总量"-q"不变 $\sigma_{\rm h}$ 改变,腔内电场分布情况改变 外表面带电总量"+q"不变 $\sigma_{\rm h}$ 不变,壳外电场分布不变。



$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \qquad E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$



每个面的面电荷密度为σ

板的面电荷密度为2σ

1. 在两边取对称的高斯面

$$ES + ES = \frac{1}{\varepsilon_0} 2\sigma S \qquad E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_{\text{to}}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_{\text{to}}}{2\varepsilon_0}$$

2. 高斯面一侧取在金属板内

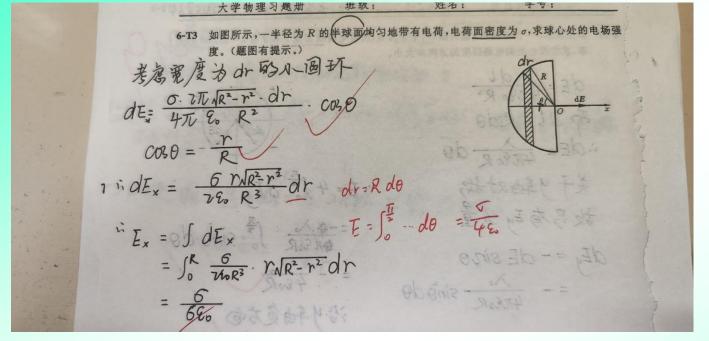
$$ES = \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma S \qquad E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_{\text{in}}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_{\text{to}}}{2\varepsilon_0}$$

6-T6 一半径为R 的带电球,其电荷体密度为 $\rho=\rho_0\left(1-\frac{r}{R}\right)$, ρ_0 为一常量,r 为空间某点至球心的距离。试求:(1) 球内、外的场强分布;(2) r 为多大时,场强最大,等于多少。 $E\int dS = \int \frac{d\theta}{z_0} = \int_0^{\rho_0} \frac{(1-\frac{r}{R})}{2\sigma} \frac{dr}{dr}$ $= \frac{\rho_0}{z_0} \int_0^{R} \frac{r}{r} \frac{1}{3z_0} \frac{1}{r} \frac{1}{2} \frac$

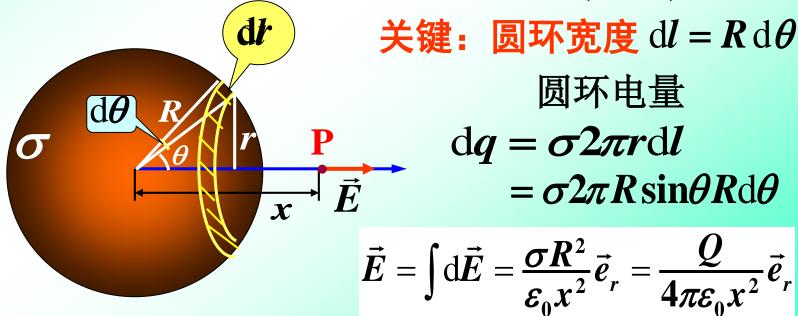
6-T8 在两个同心球面之间(a < r < b),电荷体密度 $\rho =$ 腔的中心(r = 0),有一个点电荷 Q,问 A 应为何数?

$$\Phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_S q_i$$

千万、千万、千万不要忘记



例10. 均匀带电球面,求轴上 \vec{E} =? (P201)



6-T3 如图所示,一半径为 R 的半球面均匀地带有电荷,电荷面密度为 σ,求球心处的电场强度。(题图有提示。)

dE= 4TT EOCX +13/20100012.01-

电场强处散小为一年, 前旬旬夜

上节课的相关内容



导体的静电平衡

- $\vec{E}_{\text{Pl}} = 0$
- >导体内部的电场处处为零
- ▶导体表面上的电场强度处处垂直于表面



推论

- ▶导体是等势体
- ▶导体表面是等势面

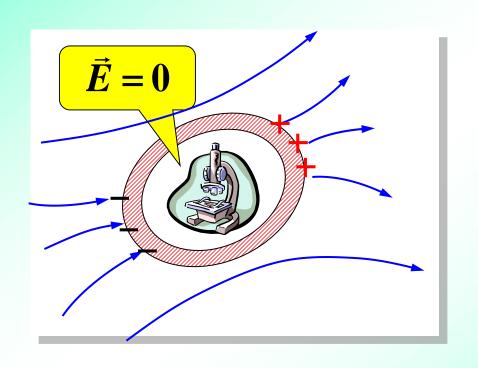
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

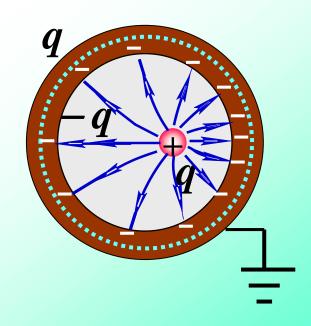
$$\sigma \propto \frac{1}{R}$$

尖端放电

上节课的相关内容

静电屏蔽





4. 有导体存在时静电场的分析与计算

例20. 将两块均匀带电的金属平板A、B平行放置,A 板单位面积带电为 σ_A =3 μ C/m², B板单位面积带电为 σ_B =7 μ C/m²。求静电平衡时,电荷分布及电场分布。(忽略边缘效应)

A B 分析: 静电平衡条件 电场迭加原理 电荷守恒 等计算 高斯定理 电势迭加

解: 设四个面上电荷面度为 σ_1 σ_2 σ_3 σ_4

 $\sigma_A = 3\mu C/m^2$ $\sigma_B = 7\mu C/m^2$

則有
$$\sigma_1 + \sigma_2 = \sigma_A$$

 $\sigma_1 + \sigma_2 = \sigma_A$
 $\sigma_3 + \sigma_4 = \sigma_B$
如图取高斯柱面可得
 E_{III} $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$ $\bigvee_i q_i = 0$
即 $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$
取 $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$
取 $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$
取 $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$
 $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$
取 $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$
 $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$
 $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$
取 $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$
 $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$
将 $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_3 + \sigma_4 = 0$
 $\sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4 + \sigma_5 + \sigma_5$

按电场叠加原理可求得

$$E_{\rm I} = -\frac{\sigma_1 + \sigma_4}{2\varepsilon_0} \qquad E_{\rm II} = \frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2\varepsilon_0} \quad E_{\rm III} = \frac{\sigma_1 + \sigma_4}{2\varepsilon_0}$$

解: 若A板接地,其与大地构成一导体

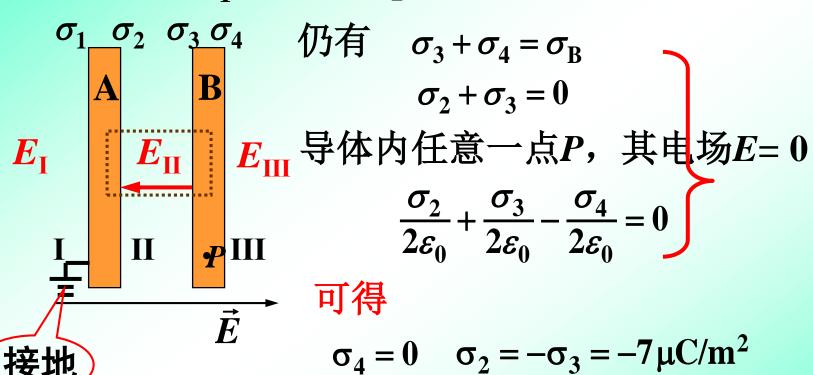
$$\sigma_A = 3\mu C/m^2$$

 $\sigma_B = 7\mu C/m^2$

$$\sigma_1 = 0$$

$$\sigma_2 \neq 0$$

$$\sigma_1 = 0$$
 $\sigma_2 \neq 0$ $\sigma_2 \neq \sigma_A$



按电场叠加原理可求得

$$E_{\rm II} = E_{\rm III} = 0$$
 $E_{\rm II} = \frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2\varepsilon_0}$

例21. 半径为R的金属球与地相连接

距d=2R处有一点电荷q(>0),

问: 球上的感应电荷q'=?

不一定!要受 "+q"的制约。

解: 球上 q'分布不均匀 需保证球体上处处电势

$$V = 0$$

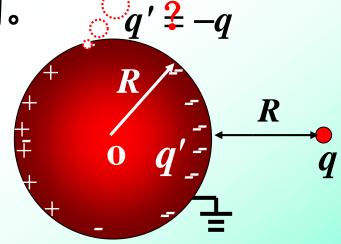
球心处:
$$V_0 = 0 = V_q + V_{q'}$$

$$V_{q} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}(2R)} = \frac{q}{8\pi\varepsilon_{0}R}$$

$$dq' \qquad q'$$

$$V_{q'} = \int_{q'} rac{\mathrm{d}q'}{4\piarepsilon_0 R} = rac{q'}{4\piarepsilon_0 R}$$

金属球接地 q'全部跑掉?



$$V_q = rac{q}{4\pi\varepsilon_0(2R)} = rac{q}{8\pi\varepsilon_0 R}$$

 $V_{q'} = \int_{q'} rac{\mathrm{d}q'}{4\pi\varepsilon_0 R} = rac{q'}{4\pi\varepsilon_0 R}$
 $\therefore q' = -rac{q}{2R}$

球心 $V_0 = 0$ 问题的关键是:

- 例22. 金属球 A 带电 q_1 =1×10⁻⁹C, 外有一同心金属球壳 B 带电 q_2 = -3×10⁻⁹C,并且 R_1 =2cm, R_2 =5cm, R_3 =10cm。
 - \vec{x} (1) 若B接地, V_A 、 V_B 各等于多少?
 - (2) 若A接地(地在无限远), A、B球上电荷分布及电势?
 - 解: (1) B接地 $V_B = 0$ $E_{fh} = 0$ 静电感应 $q_2' = -q_1 = -1 \times 10^{-9} \, \text{C}$ $q_{2fh} = 0$ $E_{AB} = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

$$V_{A} = \int_{A}^{V=0} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{q_{1}}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} dr = \frac{q_{1}}{4\pi\varepsilon_{0}} (\frac{1}{R_{1}} - \frac{1}{R_{2}}) = 270 \text{V}$$

解: (2)
$$V_A = 0$$
 $E_{AB} > 0$ $V_{\infty} = 0$
则有 $V_{BA} = V_{B\infty}$

$$\int_{R_2}^{R_1} \vec{E}_{AB} \cdot d\vec{r} = \int_{R_3}^{\infty} \vec{E}_{B\infty} \cdot d\vec{r}$$

$$\int_{R_2}^{R_1} \frac{q_1'}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot dr = \int_{R_3}^{\infty} \frac{q_1' + q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot dr$$

$$-\frac{q_1'}{4\pi\varepsilon_0} (\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}) = \frac{q_1' + q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_3}$$

$$q_1' = 0.75 \times 10^{-9}$$
 C $q_2 = -3 \times 10^{-9}$
球壳B内表面带电 $q_2' = -q_1' = -0.75 \times 10^{-9}$ C

球壳B外表面带电 $q_2 - q_2' = -2.25 \times 10^{-9}$ C

$$V_{B} = \int_{R_{3}}^{\infty} E \cdot dr = \int_{R_{3}}^{\infty} \frac{q'_{1} + q_{2}}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} dr = \frac{q'_{1} + q_{2}}{4\pi\varepsilon_{0}R_{3}} = -202.5V$$

